

اثر ضخامت نانومتری دی اکسید سیلیسیم روی آبدوستی و فوتوفکاتالیستی لایه های نازک دی اکسید سیلیسیم روی دی اکسید تیتانیم پخت شده در دماهای مختلف

یعقوبی، مریم

دانشگاه پام نور، تهران

چکیده

لایه های نازک دی اکسید سیلیسیم در ضخامت های مختلف (۱۰۵ و ۱۰۰ و ۱۸۰ نانومتر) بر روی لایه های نازک دی اکسید تیتانیم در ضخامت ۷۹ نانومتر به روش اسپاترینگ واکنشی فرکانس رادیویی رشد داده و سپس در دماهای (۲۰۰ و ۳۰۰ و ۴۰۰ و ۵۰۰ و ۶۰۰ درجه پخت شدند. خواص فوتوفکاتالیستی لایه زیری دی اکسید تیتانیم تحت تابش نور ماورای بنفش، خواص سطحی با انجام آنالیز میکروسکوپ نیروی اتمی، خواص شیمیایی با استفاده از آنالیز اسپکتروسکوپی اشعه ایکس و آبدوستی نمونه ها مورد مطالعه قرار گرفت.

The thickness effect of SiO_2 nanolayer hydrophilic and photocatalytic properties of $\text{SiO}_2/\text{TiO}_2$ thin films annealed at different temperatures

Yaghoobi, Maryam
Payame Noor University, Tehran

Abstract

SiO_2 thin layers in thicknesses (1, 5, 10, 18 nm) on the TiO_2 thin layer in thickness 79 nm deposited by reactive RF sputtering technique. The deposited films were annealed at (200, 300, 400, 500, 600°C). The surface properties of thin films by atomic force microscopy (AFM), surface chemical composition by X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), photocatalytic TiO_2 underlayer by the UV light irradiation and hydrophilic properties of the films, were studied.

PACS No. 81.15.Ef Vacuum deposition.

گروههای هیدروکسیل به وسیله اکسیژن هوا سطح فوق آبدوست در تاریکی به غیر آبدوست تبدیل می گردد [۱]. در حقیقت، یک سطح به طور دائم نمی تواند در معرض تابش نور قرار داشته باشد. مقالات زیادی گزارش داده اند که افروزن دی اکسید سیلیسیم به دی اکسید تیتانیم باعث افزایش فعالیت فوق آبدوستی و ماندگاری طولانی آن بدون تابش نور می شود [۲]. بر طبق آزمایشات اسپکتروسکوپی فوتوفکاترون اشعه ایکس تشکیل پیوندهای Ti-O-Si در فصل مشترک فیلم ها منجر به تغییرات اساسی در ساختار الکترونیکی لایه بیرونی می شود. این تغییرات باعث افزایش خاصیت اسیدی سطح و در نتیجه رغبت بیشتر برای جذب

مقدمه

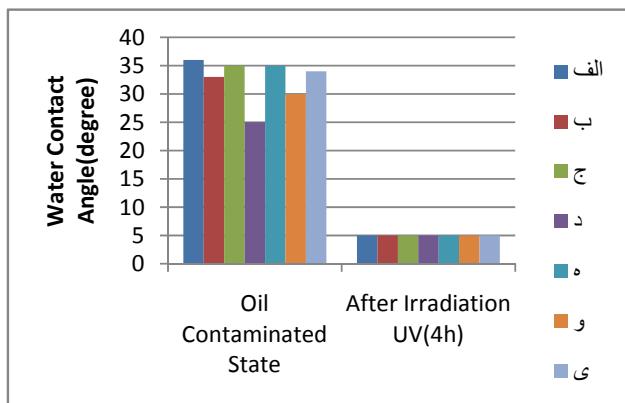
دی اکسید تیتانیم دارای خواص فوتوفکاتالیستی و فوق آبدوستی تحت تابش نور مaura بنفش می باشد. در اثر تابش نور بر روی سطح آن، زوجهای الکترون - حفره تولید شده و واکنش اکسیداسیون - احیا به طریق زیر انجام می شود:

$$\text{Ti}^{4+} + \text{e}^- \rightarrow \text{Ti}^{3+} \quad \text{O}_2 + 2\text{h}^+ \rightarrow \text{O}_2^{2-}$$

حفره های ایجاد شده در سطح می توانند توسط گروههای هیدروکسیل که به واسطه وجود مولکولهای آب در هوا تولید می گردند، اشغال شوند و در نتیجه خاصیت فوق آبدوستی سطح به وجود آید (تقریباً صفر شدن زاویه تماس آب با سطح) [۱ و ۲]. هرچند، به دلیل جایگزین شدن

ماندگاری خاصیت فوق آبدوستی

نمونه های آبدوست و فوق آبدوست را برای انجام آزمایش فوتوكاتالیستی و ماندگاری انتخاب کرده و سطح آنها را با روغن چرخ خیاطی (بهران) آلوده می کنیم و سپس به مدت ۴ ساعت تحت تابش نور ماورای بنسش قرار می دهیم. نتایج این تحقیق در شکل ۲ نشان داده شده است.



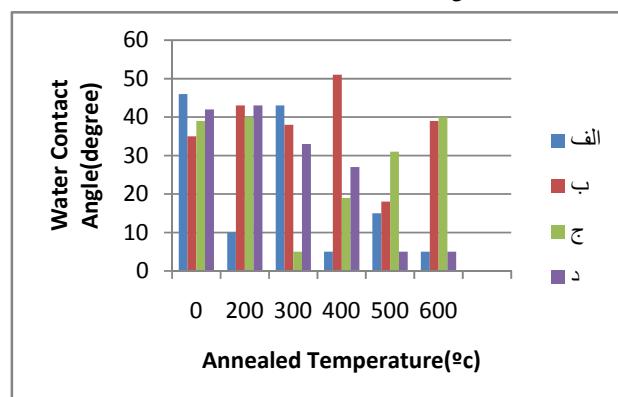
شکل ۲ : تغییرات زاویه تماس آب با سطح نمونه های آلوده پس از تابش نور برای نمونه های SiO_2 روی TiO_2 (۷۹nm) در ضخامت های:(الف)(۴۰۰°C)،(ب)(۱nm(۴۰۰°C)،(ج)(۱nm(۵۰۰°C)،(د)(۱۰nm(۳۰۰°C)،(ه)(۵nm(۵۰۰°C)،(و)(۱۰nm(۴۰۰°C)،(ي)(۱۰nm(۵۰۰°C)،(۱۸nm(۵۰۰°C)

از نمودارهای بالا این گونه استنباط می شود که آلودگی بر روی سطح نمونه ها نمی تواند مانع از فوق آبدوست شدن آنها پس از تابش نور به مدت زمان کافی شود. به عبارتی، لایه زبری دی اکسید تیتانیم می تواند نقش فوتوكاتالیستی خود را ایفا کند [۶]. سپس نمونه ها را در تاریکی داخل محفظه هایی به دور از تابش نور و آلودگی نگه می داریم و به طور منظم در فواصل زمانی یک هفته آبدوستی آنها را بررسی می کنیم. در شکل ۳ ماندگاری خاصیت فوق آبدوستی در نمونه های مورد نظر نشان داده شده است.

رادیکالهای هیدروکسیل از محیط می شود. به وجود آمدن گروههای هیدروکسیل روی سطح باعث افزایش خاصیت فوتوكاتالیستی و فوق آبدوستی سطح می گردد. در تحقیق حاضر، به دلیل پایداری فیزیکی و شیمیایی دی اکسید سیلیسیم نسبت به دی اکسید تیتانیم، فیلم های دو لایه ای بالایی دی اکسید سیلیسیم بر زمینه شیشه ساخته شدند [۴]. بنا به تحقیقات انجام شده توسط دیگران، تشکیل فصل مشترک که منجر به افزایش آبدوستی سطح می شود به دماهای به اندازه کافی بالا احتیاج دارد [۵]. بنابراین، ما نیز لایه ها را در محدوده دمایی (۲۰۰-۴۰۰°C) درجه سانتیگراد پخت نمودیم و خواص فوتوكاتالیستی و آبدوستی و نیز زبری و ترکیبات شیمیایی سطح آنها را بررسی کردیم.

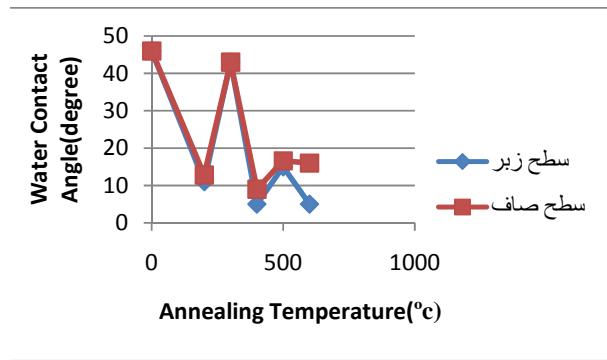
خاصیت فوق آبدوستی بدون تابش نور

پس از مشاهده و اندازه گیریهای خاصیت فوق آبدوستی فیلم های دولایه ای $\text{SiO}_2/\text{TiO}_2$ دریافتیم که بعضی نمونه ها در ضخامت ها و دماهای پخت خاصی، آبدوستی بالایی دارند. نتایج مشاهده شده در نمودارهای شکل ۱ آورده شده اند.



شکل ۱: تغییرات زاویه تماس آب با سطح لایه های $\text{SiO}_2/\text{TiO}_2$ بدون تابش (UV) در ضخامت (UV) (۷۹nm) TiO_2 (۱nm)، (الف)(۱nm)، (ب)(۱۰nm)، (ج)(۱۸nm)، (د)(۵nm)

از مقایسه این نتایج به این موضوع پی می بریم که دمای پخت تاثیر بسزایی در پیدایش فوق آبدوستی فیلم های دولایه ای دارد، به طوری که هیچ کدام از نمونه های پخت نشده این خاصیت را نشان نمی دهن.



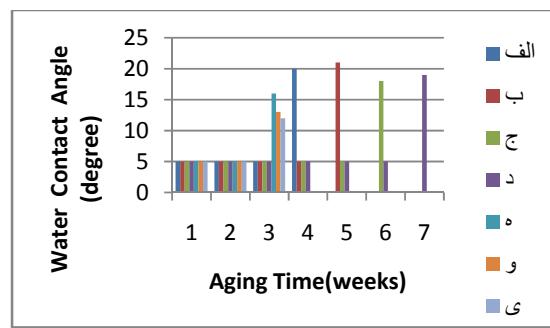
شکل ۴: تغییرات زاویه تماس آب بر سطح لایه نازک $\text{SiO}_2(79\text{nm})/\text{TiO}_2(1\text{nm})$ پر حسب دمای پخت

XPS آنالیز

به منظور بررسی استوکیومتری و یافتن ساختار شیمیایی و درصد عناصر تشکیل دهنده سطح لایه‌ها از آنالیز XPS استفاده کردیم. در این روش، از آند (AL $K_{\alpha}=1487.6\text{eV}$) و محفظه ای با خلا ما فوق بالا (UHV) و با فشار پایه حداقل 10^{-4}Torr استفاده گردید. پس از رسیدن فشار محفوظه به حد مطلوب طیف نمونه ها در بازه کامل و سپس به صورت دقیق تر در بازه های کوچک اندازه گیری شدند.

بررسی تراز انرژی O(1s)

در اندازه گیری ها، انرژی پیوندی قله کربن ($1s\text{C}$) معادل با (2850eV) در نظر گرفته شده است. برای تعیین درصد عناصر، ابتدا با انتخاب بازه مناسب و حذف اثر زمینه، طیف های اندازه گیری شده بهینه گردید. متعاقباً با انتبطاق منحنی های گوسی (90° درصد) بهترین تطبیق با نتایج تجربی حاصل گردید. اندازه گیری های انجام شده با استفاده از نرم افزار (SDP4-1) انجام شد. شکل ۵ طیف XPS لایه‌ها را در محدوده پیک (O(1s) نشان می‌دهد. چنانچه در شکل مشاهده می‌شود، هر کدام از این پیک‌ها به سه قله مجزا تقسیک می‌شوند. قله (A) نمایانگر ترکیب Ti-O-Ti و قله (B) مربوط به ترکیب Si-O-Si می‌باشد. قله (C) مابین این دو قله به گزارشات قبلی [۸]، به ترکیب Ti-O-Si نسبت داده می‌شود. از مقایسه طیف‌های دو نمونه در می‌یابیم که با افزایش دمای پخت، احتمال تشکیل این ترکیب در سطح لایه‌ها افزایش داده می‌شود.



شکل ۳: تغییرات زاویه تماس آب با سطح نمونه های آلدود بر حسب گذشت زمان پس از قطع تابش نور برای نمونه های $\text{SiO}_2(79\text{nm})/\text{TiO}_2(1\text{nm})$ در ضخامت‌های: (الف) (1nm) (400°C)، (ب) (1nm) (500°C)، (ج) (10nm) (300°C)، (د) (10nm) (400°C)، (ه) (5nm) (500°C)، (و) (5nm) (600°C)، (ي) (18nm) (500°C) ،

با مشاهده تغییرات زاویه تماس آب با سطح لایه‌ها به این نتیجه می‌رسیم که نمونه SiO_2 در ضخامت (5nm) لایه نشانی شده روی TiO_2 به ضخامت (79nm) و دمای پخت (500°C) بهترین نمونه از نظر ماندگاری خاصیت فوق آبدوستی به مدت ۵ هفته می‌باشد. پس از غیر آبدوست شدن این نمونه، آلدودگی روی سطح را به وسیله شستشو از بین بردم و فوق آبدوستی آن را بدون تابش نور ملاحظه کردیم [۷].

AFM آنالیز

برای یافتن مشخصات سطح لایه‌های نازک در ابعاد نانومتری از آنالیز میکروسکوپ نیروی اتمی استفاده کردیم. به منظور محاسبه خواص آماری سطح از برنامه IP(Proscan1.7) استفاده گردید. برای سنجش میزان تاثیر زبری سطح در آبدوستی لایه ها، زوایای تماسی قطره آب بر روی سطح لایه ها قبل از حذف زبری و بعد از آن به کمک رابطه ونzel محاسبه گردید و در نمودار شکل ۴ نشان داده شده است. همانطور که در نمودار مشاهده می‌شود، عامل زبری در نمونه های ما به استثنای لایه نازک پخت شده در دمای (400°C) دخالت چندانی در روند پیدایش آبدوستی ندارد و باید در جستجوی عوامل مهم دیگری از جمله تغییرات شیمیایی در ساختار نمونه ها باشیم.

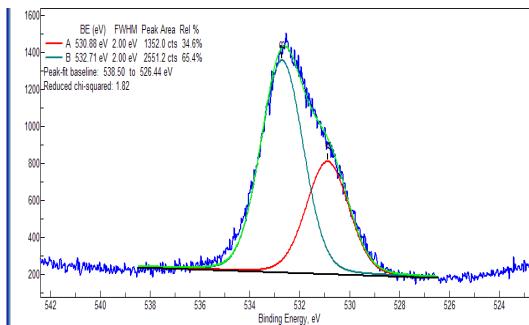
نتیجه گیری

پخت لایه‌ها باعث تشکیل پیوند Ti-O-Si در فصل مشترک لایه‌ها می‌شود. بهترین نمونه از لحاظ فوق آبدوستی و ماندگاری طولانی بدون تابش نورمادرای بنفس و فقط در اثر پخت لایه‌ها پس از لایه نشانی آنها، نمونه $\text{SiO}_2(5\text{nm}) / \text{TiO}_2(79\text{nm})$ پخت شده در دمای 500°C ارزیابی شد.

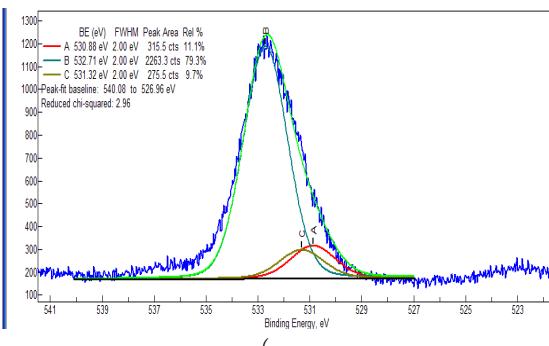
مرجع‌ها

- [۱] K. Hashimoto and H.. A.Fujishima; "TiO₂ Photocatalysis, A Historical Overview and Future Prospects"; *Applied Physics* **44**, No.12 (2005) 8269-8285.
- [۲] A. Fujishima and T.. A.Tryk; "Titanium Dioxide Photocatalysis"; *Photochemistry and Photobiology* **c**, No.1 (2000) 1-21.
- [۳] K. Guan; "Relationship Between Photocatalytic Activity, Hydrophilicity and Self-Cleaning Effect of TiO₂/SiO₂ Films"; *Surface and Coatings Technology* **191** , (2005) 155-160.
- [۴] M. Nakamura; "Hydrophilic and Photocatalytic Properties of The SiO₂/TiO₂ Double Layers"; *Thin Solid Films* **496**, (2006) 131-135.
- [۵] S. Permpoon and M.. M. Langlet; "Natural and Persistent Superhydrophilicity of SiO₂/TiO₂ and TiO₂/SiO₂ Bi-Layer Films"; *Thin Solid Films* **516**, (2008) 957-966.
- [۶] M. Nakamura and M.. T. Mochizuka; "Hydrophilic Property of SiO₂/TiO₂ Double Layer Films"; *Thin Solid Films* **502**, (2006) 121-124.
- [۷] M. Houmar and G.. M. Langlet; "Enhanced Cleanability of Superhydrophilic TiO₂-SiO₂ Composite Surface Prepared Via a Sol-Gel Rout"; *Surface Science* **605**, (2011) 456-462.
- [۸] S. Permpoon and G.. M. Langlet; "Natural Superhydrophilicity of Sol Gel Derived SiO₂-TiO₂ Composite Films"; *Mater Sci* **41**, (2006) 7650-7662.

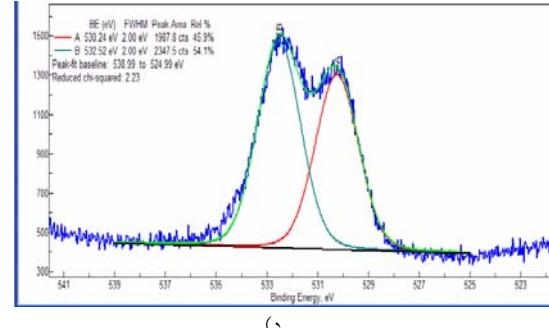
(الف)



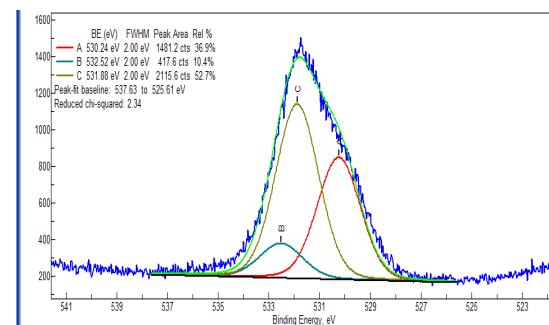
(ب)



(ج)



(د)



شکل ۸ : طیف XPS لایه‌های نازک در محدوده پیک O(1s)
الف) $\text{SiO}_2(79\text{nm}) / \text{TiO}_2(79\text{nm})$ بدون پخت و ب) پخت شده در دمای 500°C
و ج) $\text{SiO}_2(5\text{nm}) / \text{TiO}_2(79\text{nm})$ بدون پخت و د) پخت شده در دمای 500°C